제품 카탈로그

고체전력증폭기

고체 전력 증폭기는 진공관 전력 단계를 쓰지 않고 반도체 RF 전력 소자로 송신 경로의 출력 전력을 만드는 증폭기입니다. 통신 송신기, 레이더 채널, RF 시험 플랫폼, 맞춤형 마이크로파 서브시스템에 사용됩니다.



제품: 21

개정: 14 · 개정일: 2026-11-12



LCPAM-2000-6000-100-485

2–6 GHz 100 W GaN 광대역 RF 전력 증폭기 모듈

LCPAM-2000-6000-100-485는 GaN 기술을 사용하는 2–6 GHz 광대역 고출력 RF 전력 증폭기 모듈입니다. 포화 출력 대표값은 100 W, 이득 대표값은 50 dB입니다. 24–32 VDC로 동작하며 RS-485 인터페이스, 상태 모니터링 및 보호 차단 기능을 제공합니다. 50 Ω RF 시스템의 전력단으로 평가할 수 있습니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 2000; 최댓값: 6000; 단위: MHz

포화 RF 출력 전력: 기호: Pout; 일반값: 100; 단위: W

전력 이득: 기호: Gp; 일반값: 50; 단위: dB

동작 전압: 기호: VDC; 최솟값: 24; 일반값: 28; 최댓값: 32; 단위: VDC

별도 명시가 없으면 +28.0 VDC, 25 °C, 50 Ω 시스템

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-100-18000-5

100–18000 MHz GaN RF 전력 증폭기, 최소 5 W

GaN 증폭기는 100–18000 MHz를 지원하며 포화 출력은 최소 5 W, 전형 7 W입니다. 이득은 최소 37 dB, 전형 38 dB이며 전형 평탄도는 ±0.5 dB입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 100; 최댓값: 18000; 단위: MHz

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 최솟값: 5; 일반값: 7; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 최솟값: 37; 일반값: 38; 단위: dB

전력 이득 평탄도 @ PSAT: 기호: ΔGp; 일반값: ±0.5; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-10700-12700-100

10700–12700 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 100 W

GaN 증폭기는 10700–12700 MHz에서 전형 포화 출력 100 W와 이득 50 dB를 제공합니다. 전형 평탄도는 ±1 dB, 100 W 출력에서 고조파는 –50 dBc입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 10700; 최댓값: 12700; 단위: MHz

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 일반값: 100; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 일반값: 50; 단위: dB

전력 이득 평탄도 @ PSAT: 기호: ΔGp; 일반값: ±1; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω. 전원 용량을 결정하기 전에 동작 전류와 과전류 보호 동작 조건을 LCRF에 확인하십시오.

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-10700-12700-50

10700–12700 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 50 W

GaN 증폭기는 10700–12700 MHz에서 전형 포화 출력 50 W와 이득 47 dB를 제공합니다. 50 W에서 전형 동작 전류는 10 A, 정지 전류는 1.6 A입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 10700; 최댓값: 12700; 단위: MHz

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 일반값: 50; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 일반값: 47; 단위: dB

전력 이득 평탄도 @ PSAT: 기호: ΔGp; 일반값: ±1; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-10700-12750-100

10700–12750 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 100 W, WR75 어댑터

GaN 증폭기는 10700–12750 MHz에서 전형 포화 출력 100 W와 최소 이득 50 dB를 제공합니다. 1 dB 압축점의 전형 출력은 40 W, 100 W에서 전형 전류는 21 A입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 10700; 최댓값: 12750; 단위: MHz

1 dB 압축점 출력 전력: 기호: P-1dB; 일반값: 40; 단위: W

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 일반값: 100; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 최솟값: 50; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-2000-6000-20

2000–6000 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 포화 출력 25 W

이 모델의 사양서는 2000–6000 MHz에서 전형 포화 출력 25 W와 이득 44 dB를 규정합니다. 전형 전류 2.5 A와 전력 부가 효율 30%는 모두 20 W 출력 조건입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 2000; 최댓값: 6000; 단위: MHz

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 일반값: 25; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 일반값: 44; 단위: dB

전력 이득 평탄도 @ PSAT: 기호: ΔGp; 일반값: ±1; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-20-520-200A

20–520 MHz 포화 출력 200 W LDMOS RF 전력 증폭기 모듈

LDMOS 최종 단을 사용하는 모듈로, 20–520 MHz에서 포화 출력은 전형값 200 W입니다. 1 dB 압축점 출력은 별도로 전형값 50 W, 소신호 이득은 전형값 53 dB로 규정됩니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 20; 최댓값: 520; 단위: MHz

포화 RF 출력 전력: 기호: Psat; 일반값: 200; 단위: W

1 dB 압축점 출력 전력: 기호: P1dB; 일반값: 50; 단위: W

소신호 이득: 기호: G; 일반값: 53; 단위: dB

25 °C; 50 Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-20-520-350

20–520 MHz LDMOS RF 전력 증폭기, 전형 포화 출력 350 W

LDMOS 증폭기는 20–520 MHz에서 전형 포화 출력 350 W와 1 dB 압축점 출력 150 W를 제공합니다. 전형 이득 56 dB, 350 W에서 전류 29 A 및 전형 공급 전압 48 VDC입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 20; 최댓값: 520; 단위: MHz

1 dB 압축점 출력 전력: 기호: P-1dB; 일반값: 150; 단위: W

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 일반값: 350; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 일반값: 56; 단위: dB

+48.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-3000-8000-100-485

3000–8000 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 100 W, RS-485

GaN 증폭기는 3000–8000 MHz를 지원하며 포화 출력은 최소 80 W, 전형 100 W입니다. 이득은 최소 49 dB, 전형 50 dB이고 100 W 출력 시 전형 전류는 18 A입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 3000; 최댓값: 8000; 단위: MHz

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 최솟값: 80; 일반값: 100; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 최솟값: 49; 일반값: 50; 단위: dB

전력 이득 평탄도 @ PSAT: 기호: ΔGp; 일반값: ±2; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-30-1000-10

30–1000 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 10 W

GaN 증폭기는 30–1000 MHz를 지원하며 포화 출력은 최소 9 W, 전형 10 W입니다. 전형 이득은 40 dB, 평탄도는 ±1 dB이며 10 W 출력 시 전형 전류는 0.6 A입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 30; 최댓값: 1000; 단위: MHz

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 최솟값: 9; 일반값: 10; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 일반값: 40; 단위: dB

전력 이득 평탄도 @ PSAT: 기호: ΔGp; 일반값: ±1; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-30-1500-1

30–1500 MHz GaN RF 전력 증폭기, 최소 1 W

이 모듈은 30–1500 MHz에서 최소 포화 출력 1 W와 이득 30 dB를 규정합니다. 1 W 조건의 전형 전류는 0.15 A이며 전형 이득 평탄도는 ±1 dB입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 30; 최댓값: 1500; 단위: MHz

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 최솟값: 1; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 최솟값: 30; 단위: dB

전력 이득 평탄도 @ PSAT: 기호: ΔGp; 일반값: ±1; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-30-2000-1

30–2000 MHz GaN RF 전력 증폭기, 최소 1 W

전기 특성 표에 따라 30–2000 MHz를 지원하며 최소 포화 출력 1 W와 이득 30 dB를 규정합니다. 전형 고조파는 1 W에서 −12 dBc, 포화 조건의 불요 신호는 −60 dBc입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 30; 최댓값: 2000; 단위: MHz

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 최솟값: 1; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 최솟값: 30; 단위: dB

전력 이득 평탄도 @ PSAT: 기호: ΔGp; 일반값: ±1; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-5000-6000-100

5–6 GHz ≥100 W GaN RF 전력 증폭기 모듈

LCPAM-5000-6000-100은 5–6 GHz에서 최소 포화 출력 100 W, PSAT에서의 최소 이득 50 dB로 규정됩니다. 측정 조건은 28 VDC, 25 °C, 50 Ω입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 5000; 최댓값: 6000; 단위: MHz

포화 RF 출력 전력: 기호: PSAT; 최솟값: 100; 단위: W; PSAT

전력 이득 (PSAT): 기호: Gp; 최솟값: 50; 단위: dB; PSAT

전력 이득 평탄도 (PSAT): 기호: ΔGp; 일반값: ±1; 단위: dB; PSAT

28 VDC; 25 °C; 50 Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-5000-8500-25

5000–8500 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 25 W

GaN 증폭기는 5000–8500 MHz를 지원하며 포화 출력은 최소 20 W, 전형 25 W입니다. 이득은 최소 43 dB, 전형 44 dB이며 20 W에서 전형 고조파는 −40 dBc입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 5000; 최댓값: 8500; 단위: MHz

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 최솟값: 20; 일반값: 25; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 최솟값: 43; 일반값: 44; 단위: dB

전력 이득 평탄도 @ PSAT: 기호: ΔGp; 일반값: ±0.5; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-500-2500-100A

500–2500 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 100 W, A 사양

GaN A 사양은 500–2500 MHz를 지원하며 전형 포화 출력 100 W와 이득 50 dB를 제공합니다. 100 W 조건의 전형 전류는 12 A이며 고조파 측정 조건은 70 W 출력입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 500; 최댓값: 2500; 단위: MHz

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 일반값: 100; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 일반값: 50; 단위: dB

전력 이득 평탄도 @ PSAT: 기호: ΔGp; 일반값: ±2; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω 전기 사양 표는 최소 26 VDC, 전형값 28 VDC, 최대 30 VDC를 지정하지만 A1 VDD 행은 28–32 VDC를 표시합니다. A1 전원 범위 주장은 게시하지 않습니다. 전원을 인가하기 전에 허용 범위와 A1 배선을 확인해야 하며 32 VDC는 여기서 승인된 동작 최대값이 아닙니다.

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-6000-18000-50

6–18 GHz 솔리드 스테이트 RF 전력 증폭기, 전형 50 W

솔리드 스테이트 증폭기는 6–18 GHz에서 0 dBm 입력 시 최소 포화 출력 45 W와 전형 50 W를 규정합니다. 전형 이득은 47 dB, 같은 입력 조건의 평탄도는 전형 ±1.5 dB, 최대 ±2.5 dB입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 6; 최댓값: 18; 단위: GHz

포화 RF 출력 전력 @ Pin = 0 dBm: 기호: Psat; 최솟값: 45; 일반값: 50; 단위: W

전력 이득 @ Pin = 0 dBm: 기호: Gp; 일반값: 47; 단위: dB

전력 이득 평탄도 @ Pin = 0 dBm: 기호: ΔGp; 일반값: ±1.5; 최댓값: ±2.5; 단위: dB

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-6000-8500-20

6000–8500 MHz GaN RF 전력 증폭기, 최소 20 W

이 모델 사양서는 6000–8500 MHz에서 최소 포화 출력 20 W와 전형 25 W를 규정합니다. 전형 전류 2.5 A와 전력 부가 효율 30%는 20 W 조건이며 전형 정지 전류는 1.8 A입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 6000; 최댓값: 8500; 단위: MHz

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 최솟값: 20; 일반값: 25; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 최솟값: 43; 일반값: 44; 단위: dB

전력 이득 평탄도 @ PSAT: 기호: ΔGp; 일반값: ±0.5; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-6000-8500-25

6000–8500 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 25 W

이 모델은 6000–8500 MHz에서 전형 포화 출력 25 W와 최소 20 W를 규정합니다. 이득은 전형 44 dB, 최소 43 dB이며 전형 평탄도는 ±0.5 dB입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 6000; 최댓값: 8500; 단위: MHz

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 최솟값: 20; 일반값: 25; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 최솟값: 43; 일반값: 44; 단위: dB

전력 이득 평탄도 @ PSAT: 기호: ΔGp; 일반값: ±0.5; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAM-8000-12000-100

8000–12000 MHz GaN RF 전력 증폭기, 전형 100 W

GaN 증폭기는 8000–12000 MHz에서 전형 포화 출력 100 W와 최소 이득 53 dB를 제공합니다. 1 dB 압축점 전형 출력은 20 W, 이득 평탄도는 ±1.5 dB입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 8000; 최댓값: 12000; 단위: MHz

1 dB 압축점 출력 전력: 기호: P-1dB; 일반값: 20; 단위: W

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 일반값: 100; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 최솟값: 53; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAS-8000-12000-200

8000–12000 MHz GaN RF 전력 증폭 시스템, 전형 200 W

GaN 시스템은 8000–12000 MHz에서 전형 포화 출력 200 W와 1 dB 압축점 출력 40 W를 제공합니다. 최소 이득은 53 dB, 전형 이득 평탄도는 ±1.5 dB입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 8000; 최댓값: 12000; 단위: MHz

1 dB 압축점 출력 전력: 기호: P-1dB; 일반값: 40; 단위: W

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 일반값: 200; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 최솟값: 53; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트



LCPAS-8000-12000-400

8000–12000 MHz GaN RF 전력 증폭 시스템, 전형 400 W

GaN 시스템은 8000–12000 MHz에서 전형 포화 출력 400 W와 1 dB 압축점 출력 120 W를 규정합니다. 최소 이득은 56 dB, 전형 이득 평탄도는 ±1.5 dB입니다.

동작 주파수: 기호: BW; 최솟값: 8000; 최댓값: 12000; 단위: MHz

1 dB 압축점 출력 전력: 기호: P-1dB; 일반값: 120; 단위: W

RF 출력 전력 @ PSAT: 기호: PSAT; 일반값: 400; 단위: W

전력 이득 @ PSAT: 기호: Gp; 최솟값: 56; 단위: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

제품 상세 제품 데이터시트

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.